(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4772507号

(P4772507)

(45) 発行日 平成23年9月14日(2011.9.14)

(24) 登録日 平成23年7月1日 (2011.7.1)

(51) Int.Cl.			FΙ		
CO4B	41/87	(2006.01)	C O 4 B	41/87	М
CO4B	35/581	(2006.01)	C O 4 B	35/58	104Q
H01L	35/34	(2006.01)	HO1L	35/34	

請求項の数 6 (全 41 頁)

(21) 出願番号 (86) (22) 出願日	特願2005-517287 (P2005-517287) 平成17年1月21日 (2005.1.21)	(73)特許権者 000003182 株式会社トクヤマ
(86) 国際出願番号	PCT/JP2005/000791	山口県周南市御影町1番1号
(87) 国際公開番号	W02005/070851	(73) 特許権者 304021417
(87) 国際公開日	平成17年8月4日 (2005.8.4)	国立大学法人東京工業大学
審査請求日	平成19年7月23日 (2007.7.23)	東京都目黒区大岡山2丁目12番1号
(31) 優先権主張番号	特願2004-15882(P2004-15882)	(74)代理人 100103218
(32) 優先日	平成16年1月23日 (2004.1.23)	弁理士 牧村 浩次
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(74)代理人 100107043
(31) 優先権主張番号	特願2004-26287 (P2004-26287)	弁理士 高畑 ちより
(32) 優先日	平成16年2月3日 (2004.2.3)	(74)代理人 100110917
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	弁理士 鈴木 亨
(31) 優先権主張番号	特願2004-31731 (P2004-31731)	(72)発明者 福山 博之
(32) 優先日	平成16年2月9日 (2004.2.9)	宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	┃ 大学 多元物質科学研究所内
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス、その製造方法およびその用途

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

非酸化物セラミックスの表面を酸化して表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス を製造する方法であって、

(1) 非酸化物セラミックスを準備する工程、

(2)前記非酸化物セラミックスを炉内に導入した後に、当該非酸化物セラミックスおよび炉材に吸着もしくは収着している酸化性物質を炉外に排出し、炉内の雰囲気を1m³に 含まれる酸化性ガスの合計モル数が0.5mmol以下である雰囲気とする工程、

(3) 炉内の雰囲気を1m³に含まれる酸化性ガスの合計モル数が0.5mmol以下で ある雰囲気に保ちながら前記非酸化物セラミックスを非酸化物セラミックスの酸化開始温 度より300 低い温度以上の温度に加熱する工程、

10

(4)前記工程(3)で加熱された非酸化物セラミックスと酸化性ガスとを接触させた後、非酸化物セラミックスの酸化開始温度より高い温度に保持して当該非酸化物セラミックスの表面に酸化物層を形成する工程を含み、

且つ前記工程(4)において前記非酸化物セラミックスと酸化性ガスとの接触に際して、両者の接触を開始し、前記非酸化物セラミックスの温度が非酸化物セラミックスの酸化開始温度以上となってから少なくとも2分を経過するまでの間は酸化性ガスの圧力または分圧を50kPa以下とし、

前記非酸化物セラミックスは窒化アルミニウムである ことを特徴とする方法。 【請求項2】

請求項1に記載の方法により、表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスからなる 冷却ジャケットを作製し、

(2)

前記冷却ジャケットを備えるとともに、発熱体と、冷却媒供給手段を備え、前記発熱体 と前記冷却ジャケットは熱的に接触すると共に該冷却ジャケットの内部には前記冷媒供給 手段から冷却媒が供給され、更に前記冷却ジャケットの少なくとも前記冷却媒と接触する 面の表面には酸化物層が形成されている冷却装置<u>を製造する</u>

<u>冷却装置の製造方法</u>。

【請求項3】

<u>請求項1に記載の方法により表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスを製造する</u>10 、表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスからなる耐プラズマ性部材<u>の製造方法</u>。

【請求項4】

<u>前記耐プラズマ性部材が</u>プラズマ生成機構を備えた半導体または液晶製造装置における チャンバー構成部材である請求項3に記載の耐プラズマ性部材の製造方法。

【請求項5】

<u>前記耐プラズマ性部材が</u>ウェハ保持器である請求項<u>4</u>に記載の耐プラズマ性部材<u>の製造</u> 方法。

【請求項6】

<u>前記耐プラズマ性部材が</u>高周波導入用窓材である請求項<u>3</u>に記載の耐プラズマ性部材<u>の</u> 製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、窒化アルミニウムや窒化珪素等の非酸化物セラミックスの表面にそれぞれ酸 化アルミニウムや酸化珪素等の酸化物層が形成された表面に酸化物層を有する非酸化物セ ラミックスおよびその製造方法に関する。

また、本発明は、上記非酸化物セラミックスの用途、特に冷却装置および耐プラズマ部 材に関する。

【背景技術】

[0002]

窒化アルミニウムや窒化珪素等の非酸化物セラミックスは、高い熱伝導性又は高い耐熱 衝撃性等の優れた特徴を有しており、電子回路基板、自動車用エンジン部材等様々な分野 に使用されている。

このような非酸化物セラミックスのひとつの応用として、半導体素子等の発熱体を冷却 するための冷却装置がある。

[0003]

すなわち、半導体素子の高出力化に伴う発熱量増大に伴い、半導体素子を効率的に冷却 することに対する要求が高まっている。このような要求に応えるために高熱伝導率を有す る窒化アルミニウム等の非酸化物セラミックスからなる冷却ジャケットを発熱体に熱的に 接触せしめ、該冷却ジャケット内部に設けられた空洞に水又は水性溶液を冷却媒として流 通させて発熱体の冷却を行なう冷却装置が提案されている。

【0004】

ところが、上記冷却装置においては、冷却ジャケットを構成する非酸化物セラミックス の表面に水分が接触すると加水分解が起こり、その機械的強度が著しく低下するという問 題があった。たとえば非酸化物セラミックスとして窒化アルミニウムを用いた場合には、 水との接触により表面に水酸化アルミニウムが形成されるとともにアンモニアが生成され 窒化アルミニウムの加水分解が進行してしまう。なお、このとき窒化アルミニウムの表面 に形成された水酸化アルミニウムは加水分解を抑制するが、アンモニアの生成によるpH の上昇によってこの水酸化アルミニウムは溶解してしまう。

[0005]

20

30

このような問題を解決するために、非酸化物セラミックスの表面に酸化物層を形成して 非酸化物セラミックスを保護する方法が提案されているが、従来の方法で形成される酸化 物層には下地の非酸化物セラミックス層に達するポアやマイクロクラック等の欠陥が存在 するため、その保護効果は十分なものとは言えず、この効果を補うためには冷却媒中に含 まれるイオン化物を除去する等、冷却媒の管理を厳密に行なう必要があった(引用文献1 参照)。

(3)

【 0 0 0 6 】

ところが、冷却媒中のイオン化物を除去するためには専用の装置が必要であり、冷却装 置全体のコンパクト化の障害となるばかりでなくコストの面でも好ましくない。

また、非酸化物セラミックスを耐プラズマ性部材として利用することも検討されている ¹⁰ 。半導体や液晶の製造装置においてチャンバー構成部材の多くは、耐熱性の必要性やウェ ハの汚染回避のためセラミックス材料により形成されている。現在、こうしたセラミック ス材料の多くはアルミナセラミックスであるが、ウェハの大型化に伴うウェハ全面での均 熱化のためには高熱伝導性を有する窒化アルミニウム等の窒化物セラミックスの利用が増 加している。

[0007]

ところで、半導体や液晶の製造プロセスには、半導体ウェハや液晶用ガラス基板などの ウェハに薄膜を形成したり、エッチング加工を施したりする処理工程があり、これらの工 程では、該製造装置のチャンバー内に、ハロゲン系腐食性ガスの存在下でマイクロ波等の 高周波を導入してプラズマを発生させて処理を遂行することが多い。ここで、ハロゲン系 腐食性ガスなどのプラズマは高い腐食性を有している。また、上記チャンバー構成部材に 窒化物セラミックスが使用されていると、その高熱伝導性のために該部材は高熱に曝され ることになる。

[0008]

これらの結果、該チャンバー構成部材の表面にはセラミックスと反応したハロゲン化物 が生成し、例えばそのハロゲン化物が塩化物の場合には融点が低いのでウェハ処理温度で 昇華し表面の腐食が進み汚染の原因になるパーティクルが発生する。また、上記腐食がさ らに進むと、大きな凹部ができ、チャンバー構成部材表面の形状安定性が悪化して、例え ば該部材がウェハ保持器であった場合には、その保持の確実性を低下させるなど、各部材 の性能発揮に支障をきたす問題があった。特に、こうした劣化の問題は、上記チャンバー 構成部材のうち、静電チャックやサセプタなどのウェハ保持器やプラズマ生成機構からの 高周波導入用窓材等において顕著であった。

[0009]

そこで、従来より、窒化物セラミックスからなるチャンバー構成部材の耐プラズマ性を 改善するために、種々の手法が提案されており、その中の有効な手法として、窒化アルミ ニウムを大気中等の酸化性雰囲気中で加熱して表面に酸化アルミニウム層を形成する技術 等が知られている(特許文献2参照)。

しかしながら、窒化物セラミックスの表面に従来の方法でこれら酸化物層を形成した場合、形成された酸化物層は、緻密性が低く、比較的幅が広く枝分かれの多いクラックが数 多く発生するものであった。そして、このような酸化物層を表面に有する窒化物セラミッ クスでは、耐プラズマ性の改善効果も十分ではなく、これをチャンバー構成部材として使 用しても、前記した種々の問題において今一歩満足できないものであった。 【0010】

このように非酸化物セラミックスにおいては、その特徴を更に高めるため、或いはその 欠点を補うために表面に酸化層を形成することが行なわれている。上記の他にも、たとえ ば、窒化アルミニウムについては、回路基板として用いる際の金属層との接着性を改良す るため或いはアルカリ性溶液で洗浄を行なう際の耐性や耐水性を向上させるために窒化ア ルミニウム焼結体基板を大気中等の酸化性雰囲気中で加熱して表面に酸化アルミニウム層 を形成する技術が知られている(特許文献3~5及び非特許文献1参照)。また、窒化珪 素においては、窒化珪素焼結体からなる部材の高強度化のためにその表面を酸化してクリ 30

20

ストバライトを含む層を形成する技術が知られている(特許文献6参照)。 【0011】

しかしながら、非酸化物セラミックス、例えば代表的な窒化物セラミックスである窒化 アルミニウムの表面に従来の方法で酸化膜を形成した場合には、前記したように形成され た酸化膜には比較的幅が広く枝分かれの多いクラックが数多く発生し、酸化膜形成による 高性能化或いは高機能化が十分に実現されていない。

【0012】

そこで本発明者等のメンバーは、非酸化物セラミックスの表面に良好な酸化膜を形成す るためには非酸化物セラミックスの酸化メカニズムを知る必要があると考え、窒化アルミ ニウム粉末を用いてその酸化メカニズムを解明するための検討を行なった。その結果、窒 化アルミニウム粉末を酸素ガス中で加熱したときの酸化は、図1に示されるように3つの ステップからなっていることが明らかとなった。即ち、図1は、窒化アルミニウム粉末を 酸素雰囲気中で75 /分の昇温速度で加熱したときの反応率の経時変化を示したもので あり、上段のグラフでは横軸に時間(秒)を、縦軸に熱重量分析による反応率(%)及び 昇温パターンに対応する温度(K)をとっており、下段のグラフでは横軸に時間(秒)を 、縦軸に示差熱分析により測定された発熱量を示すDTA(E/mV)及び昇温パター ンに対応する温度(K)をとっている。図1のグラフは、I~IIIの3つの段階に分ける ことができる。 I段階は、窒化アルミニウムを室温から1100 (1373K)まで加 熱する期間に当たる段階であり、該段階においては酸素が窒化アルミニウムに固溶するだ けで、酸化は殆ど生じない。温度が約1100 に達した後の日段階では、固溶していた 酸素が一気に反応してA1。O。(- アルミナ)に変化することにより、急激な重量の増 加をもたらすと共に、大きな発熱が生じる。そして、このような急激な反応が収まった後 の111段階では反応は酸素の拡散律速で緩やかに進行するようになる。

【0013】

このような酸化メカニズムから、窒化アルミニウムに緻密な酸化膜を施すには、窒化ア ルミニウムを窒素中で酸素を固溶させないで1100 まで昇温し、その状態で雰囲気を 酸素に切替えて酸化させることが有効であり、そのような方法により窒化アルミニウム粉 末の表面状態を殆ど変化させずに酸化被膜を形成できることが判明した(非特許文献2参 照)。

【特許文献1】特開2000-150752号公報 【特許文献2】特開平9-232409号公報 【特許文献3】特開平10-152384号公報 【特許文献4】特開平6-116071号公報 【特許文献5】特開昭62-123071号公報 【特許文献6】特開昭62-252388号公報

【非特許文献1】ペトラ クルーグ - ウェイス等,「パワーハイブリッド用窒化アルミニ ウム基板の直接接合銅メタライゼーション」,マテリアルズリサーチ学会シンポジウムプ ロシーディング,1985年,第40巻,p.399-404(Petra Kluge-Weiss and Jens Gobrecht, "DIRECTRY BONDED COPPER METALLIZATION OF AIN SUBSTRATES FOR POWE R HYBRIDS", Materials Research Society,Symp. Proc., vol.40, p.399-404, 1985) 【非特許文献2】福山博之ら,2002年資源・素材学会,講演予稿集,p.351-352(2 002年9月23日発行)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0014]

更に、前記本発明者等のメンバーは、粉末ではなく窒化アルミニウム成形体について前 記の新しい酸化法、即ち、窒化アルミニウムの酸化反応が急激に開始される温度(反応開 始温度)に達するまでは酸化性ガスを含まない雰囲気中で窒化アルミニウム成形体を加熱 し、反応開始温度に達した時点ではじめて窒化アルミニウム成形体と酸化性ガスとを接触 させて酸化させる方法(以下、単に新酸化法ともいう)を適用した場合にも前記したよう 10

20

30

な特徴的なクラックがない酸化膜が得られ、そのような酸化膜を有する窒化アルミニウム 成形体は耐水性や耐薬品性が高いことを確認している(特開2004-91319号公報)。

【0015】

このような優れた効果が得られるのは、従来の酸化法では昇温過程において酸素が窒化 アルミニウム中に固溶し、基材温度が酸化反応の反応開始温度に達すると固溶していた酸 素が一気に反応するため下地と酸化層との格子定数の違い等に起因する急激な応力発生に よって酸化層に前記したようなクラックが発生してしまうのに対し、上記の新酸化法では 昇温中に酸素の固溶は起こらず、基材の酸化反応は反応開始温度に達し酸素と接触してか ら始まり、酸素の拡散律速で徐々に進行するので上記のようなクラックが発生しないため である。なお、この新酸化法で酸化膜を形成した場合、形成される膜厚が厚くなるとクラ ックが発生することもあるが、このときに発生するクラックは、幅が小さく枝分かれも少 ないものであり、その数(単位面積当たりのクラック数)も従来法におけるクラックのそ れと比べてはるかに少ない。

【0016】

しかしながら、上記新酸化法で得られる"表面に酸化膜を有する窒化アルミニウム成形体"を冷却装置用部材や耐プラズマ性部材に適用するために各種試験を行なったところ、 ヒートサイクル試験後に酸化膜の剥がれが起こる場合があることが明らかとなった。

本発明者等は、上記のような問題が起こる原因は、窒化アルミニウム成形体と酸化膜と の界面に何らかの欠陥があるためではないかと考えた。つまり、窒化アルミニウム粉末の 各粒子の表面に酸化膜を形成する場合と異なり、例えば基板のような成形体を酸化する場 合には、連続した大きな面積を有する面上に全面に渡って酸化膜が形成されるため、ヒー トサイクル試験を行うと両者の熱膨張係数の差に起因する歪により大きな応力が発生する ようになる。このときに両者の界面近傍に欠陥が存在すると、その欠陥を起点として破壊 が進行し、膜剥がれが起こるのではないかと考えた。そして、そのような欠陥を発生させ ることなく理想的に酸化膜形成ができればこのような問題の発生を防止することができる のではないかと考え、その方法について検討を行なった。

即ち、本発明は、クラックを発生させることなく非酸化物セラミックス成形体の表面に 良好に密着した酸化物層を形成する方法を提供し、より高性能化・高機能化された非酸化 物セラミックス焼結体を提供することを目的とする。

また、本発明は冷却媒中のイオン化物除去の必要の無い冷却装置を提供することを目的 とする。

【0018】

さらに、本発明は、表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスにおいて、酸化物層 の緻密性を向上させてプラズマに曝されても、セラミックス表面にパーティクルが発生せ ず、また、高い形状安定性を維持している優れた耐プラズマ性部材を提供することを目的 とする。

【課題を解決するための手段】

【0019】

40

50

10

20

30

本発明は、前記の新酸化方法の改良することにより、窒化アルミニウム成形体の表面での理想的な酸化膜形成を可能にしようとして行った各種検討により得られた下記(1)~ (3)に示す知見に基づきなされたものである。

【0020】

即ち、本発明は、(1)大気中で昇温加熱し酸化膜を形成する従来酸化法や前記の新酸 化法で得られた「表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス」を詳細に分析した結果 、非酸化物セラミックスとの界面近傍の酸化物層に空隙が発生しているという知見、(2) 前記新酸化法において、加熱処理前に窒化アルミニウム成形体を導入した炉内を真空脱 気するというディーガス(degas)処理をしてから超高純度不活性ガスを導入して加熱を 開始することにより、窒化アルミニウム成形体や炉材から放出されるガスの影響を可及的 に排除して窒化アルミニウム焼結体基板を加熱する際の雰囲気中に含まれる水分及び酸素 の濃度を高度に制御し、かつ酸化反応初期における酸化性ガスの圧力を特定範囲に制御し た場合には、得られる「表面に酸化膜を有する窒化アルミニウム成形体」は、その酸化膜 に前記したような特徴的なクラックが見られないというマクロ構造的な特徴を有すること に加えて、窒化アルミニウム成形体と酸化膜との界面近傍の領域に空隙が全く見られない というミクロ構造的な特徴を有するという知見、及び(3)このような現象は窒化アルミ ニウム成形体に限らず、窒化アルミニウム粉末は勿論、その他の窒化物セラミックスや炭 化物セラミックス等の非酸化物系セラミックスの成形体や粉末においても適用され得ると いう知見に基づきなされたものである。

【0021】

10

を要旨としている。 [1]非酸化物セラミックスの表面を酸化して表面に酸化物層を有する非酸化物セラミッ

そして、上記のような課題の解決を目的とする本発明は、下記[1]~[10]の事項

クスを製造する方法であって、

(1) 非酸化物セラミックスを準備する工程、

(2)前記非酸化物セラミックスを炉内に導入した後に、当該非酸化物セラミックスおよび炉材に吸着もしくは収着している酸化性物質を炉外に排出し、炉内の雰囲気を1m³に 含まれる酸化性ガスの合計モル数が0.5mmol以下である雰囲気とする工程、

(3) 炉内の雰囲気を1m³に含まれる酸化性ガスの合計モル数が0.5mmol以下で ある雰囲気に保ちながら前記非酸化物セラミックスを当該非酸化物セラミックスの酸化開 始温度より300 低い温度以上の温度に加熱する工程、

(4)前記工程(3)で加熱された非酸化物セラミックスと酸化性ガスとを接触させた後 、当該非酸化物セラミックスの酸化開始温度より高い温度に保持して当該非酸化物セラミ ックスの表面に酸化物層を形成する工程を含み、

且つ前記工程(4)において前記非酸化物セラミックスと酸化性ガスとの接触に際して、 両者の接触を開始し、前記非セラミックスの温度が当該非酸化物セラミックスの酸化開始 温度以上となってから少なくとも2分を経過するまでの間は酸化性ガスの圧力または分圧 を50kPa以下とすることを特徴とする方法。

[2]金属または半金属の窒化物又は炭化物からなる非酸化物セラミックスの表面に、当該金属または半金属元素と同一の元素の酸化物からなる厚さ0.1~100µmの酸化物層が形成され、前記酸化物層における前記非酸化物セラミックスと前記酸化物層の界面から少なくとも20nmの厚さの領域に空隙が実質的に存在しないことを特徴とする表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス。

[3]分岐を有するクラックであって、当該分岐を有するクラックを互いに隣り合った分 岐点間のクラックユニット及び端部からその直近の分岐点までのクラックユニットに分割 した場合において、各クラックユニットの長さ及び最大幅を夫々1(nm)及びw(nm)としたときに、wが20nm以上でありIが500nm以上であり且つw/1が0.0 2以上となるクラックユニットを有する分岐を有するクラックが、前記酸化物層の表面に 実質的に存在しないことを特徴とする[2]に記載の表面に酸化物層を有する非酸化物セ ラミックス。

[4]非酸化物セラミックスが窒化アルミニウム焼結体からなり、酸化物層が実質的に多 結晶 - アルミナからなる[2]又は[3]に記載の表面に酸化物層を有する非酸化物セ ラミックス。

[5]上記[1]に記載の方法で製造される表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス。

[6]発熱体と、[2]~[5]の何れかに記載の表面に酸化物層を有する非酸化物セラ ミックスからなる冷却ジャケットと、冷却媒供給手段を備え、前記発熱体と前記冷却ジャ ケットは熱的に接触すると共に該冷却ジャケットの内部には前記冷媒供給手段から冷却媒 が供給され、更に前記冷却ジャケットの少なくとも前記冷却媒と接触する面の表面には酸 化物層が形成されている冷却装置。 30

20

[7]上記[2]~[5]の何れかに記載の表面に酸化物層を有する非酸化物セラミック スからなる耐プラズマ性部材。

[8]プラズマ生成機構を備えた半導体または液晶製造装置におけるチャンバー構成部材である[7]に記載の耐プラズマ性部材。

[9]ウェハ保持器である[8]に記載の耐プラズマ性部材。

[10]高周波導入用窓材である[9]に記載の耐プラズマ性部材。

【発明の効果】

【0022】

本発明の方法によれば、窒化アルミニウムや窒化珪素等の窒化物系セラミックス、炭化 珪素等の炭化物系セラミックスなどの非酸化物セラミックスの表面に非常に高品位な酸化 膜を形成することができ、従来法(酸化性雰囲気中で昇温して酸化する方法)で酸化した 場合と比べて酸化膜の形成によりもたらせる様々な効果、例えば耐水性や耐薬品性の向上 、耐プラズマ性の向上、機械的強度の向上といった効果をより高いものとすることができ る。また、本発明の方法で製造される「表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス」 は、その酸化層が、従来法で形成された酸化膜で観測される分岐の多い特徴的なクラック を実質的に含まないばかりでなく非酸化物セラミックス基材との界面近傍に空隙が実質的 に存在しないという構造的特徴を有するため、非酸化物セラミックス基材と酸化物層との 密着強度が非常に高い。このため、上記したような様々な効果の信頼性や耐久性も高くす ることができる。

[0023]

本発明の冷却装置は、その冷却ジャケットが熱伝導性の高い非酸化物セラミックスから 成っているにもかかわらず、その接液面が高品質の酸化物層で覆われているため、冷却媒 として水や水性溶液を用いても非酸化物セラミックスが劣化することが無い。更に、酸化 物層は下地の非酸化物セラミックスと強固に密着している。そのため、冷却媒に含まれる イオン化物の量を厳重に特に管理しなくても長期間安定に使用することができる。 【0024】

本発明の耐プラズマ性部材は、窒化アルミニウム等の非酸化物セラミックスで形成され ているにも拘わらず、表面には、幅が広く枝分かれの多いクラックは形成されておらず緻 密性が高いため、ハロゲン系腐食性ガスなどのプラズマに曝されても劣化が生じ難い。す なわち、こうしたプラズマに曝された場合において、表面の腐食による劣化が大きく低減 できる。したがって、部材が半導体や液晶の製造プロセスにおいて使用されるチャンバー 構成部材であった場合においては、表面の腐蝕によるパーティクルの発生が抑制でき、ウ ェハの汚染防止に大きな効果が発揮される。

【0025】

また、さらに、腐食が進んだ時に引き起こされる、部材表面の形状変化も抑制でき、例 えば、上記チャンバー構成部材のウェハ保持器として使用した際には、ウェハ保持の確実 性が長期間にわたって維持できる。

その他、表面に緻密な酸化物層が形成されているため、内部への熱伝導の均一性も改善 され、放熱性状や温度分布の均一化にも有効である。更に、酸化物層は下地の非酸化物セ ラミックスと強固に密着しているため、たとえば使用環境の温度変化が大きいといった過 酷な条件下で使用された場合でもその効果を長期間保つことができる。

40

10

20

30

【0026】

【図面の簡単な説明】

【図1】本図は、酸素ガス雰囲気中で窒化アルミニウム基板を加熱したときの反応率及び DTAの変化パターンを示すグラフである。

【図2】本図は、特定クラックを説明するための図である。

【図3】本図は、実施例1で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の酸 化物層の表面のSEM写真である。

【図4】本図は、図3のSEM写真のスケッチである。

【図5】本図は、実施例1で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の酸 50

(7)

10

20

30

40

50

化物層の断面のTEM写真である。 【図6】本図は、図5のTEM写真のスケッチである。 【図7】本図は、実施例2で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の酸 化物層の表面のSEM写真である。 【図8】本図は、図7のSEM写真のスケッチである。 【図9】本図は、実施例2で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の酸 化物層の断面のTEM写真である。 【図10】本図は、図9のTEM写真のスケッチである。 【図11】本図は、比較例1で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のSEM写真である。 【図12】本図は、図11のSEM写真のスケッチである。 【図13】本図は、比較例2で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のSEM写真である。 【図14】本図は、図13のSEM写真のスケッチである。 【図15】本図は、比較例1で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の断面のTEM写真である。 【図16】本図は、図15のTEM写真のスケッチである。 【図17】本図は、比較例2で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のTEM写真である。 【図18】本図は、図17のTEM写真のスケッチである。 【図19】本図は、本発明の代表的な冷却装置の冷却系統図である。 【図20】本図は、実施例8で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のSEM写真である。 【図21】本図は、図20のSEM写真のスケッチである。 【図22】本図は、実施例8で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の断面のTEM写真である。 【図23】本図は、図22のTEM写真のスケッチである。 【図24】本図は、実施例8で得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタに対して、 耐食試験日を実施する際のプラズマ処理前の表面状態を示すSEM写真である。 【図25】本図は、上記図24の表面酸化窒化アルミニウム製サセプタにおいて、プラズ マ処理後の表面状態を示すSEM写真である。 【図26】本図は、表面に酸化層を有しない窒化アルミニウム製サセプタに対して、耐食 試験目を実施する際のプラズマ処理前の表面状態を示すSEM写真である。 【図27】本図は、上記図24の表面酸化窒化アルミニウム製サセプタにおいて、プラズ マ処理後の表面状態を示すSEM写真である。 【図28】本図は、実施例9で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のSEM写真である。 【図29】本図は、図28のSEM写真のスケッチである。 【図30】本図は、実施例9で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の断面のTEM写真である。 【図31】本図は、図30のTEM写真のスケッチである。 【図32】本図は、比較例7で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のSEM写真である。 【図33】本図は、図32のSEM写真のスケッチである。 【図34】本図は、比較例8で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のSEM写真である。 【図35】本図は、図34のSEM写真のスケッチである。 【図36】本図は、比較例7で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の断面のTEM写真である。 【図37】本図は、図36のTEM写真のスケッチである。

(8)

10

20

30

【図38】本図は、比較例8で得られた表面に酸化物層を有する窒化アルミニウム基板の 酸化物層の表面のTEM写真である。 【図39】本図は、図38のTEM写真のスケッチである。 【符号の説明】 [0027]1・・・分岐を有するクラック 2 a ~ 2 e · · · クラックユニット 1 a ~ 1 e · · · 各クラックユニットの長さ wa~we・・・各クラックユニットの最大幅 (I)・・・発熱体冷却ユニット (II)・・・冷却媒供給ユニット 100・・冷却装置 A・・・基板 B・・・発熱体 C・・・冷却媒 D・・・冷却ジャケット E ・・・ 配管 **F**・・・タンク G・・・ポンプ H・・・熱交換器 【発明を実施するための最良の形態】 本発明の製造方法では、先ず非酸化物セラミックス(以下、単に被処理セラミックスと もいう)を準備する。 本発明において、酸化膜が形成される非酸化物セラミックス(被処理セラミックス)と しては、金属又は半金属の窒化物又は炭化物で融点若しくは分解温度が酸化開始温度以上 のものであれば特に限定されず、公知の窒化物又は炭化物を使用することができる。本発 明で好適に使用できる非酸化物セラミックスを具体的に例示すれば、窒化アルミニウム、 窒化珪素、窒化ホウ素等の窒化物系セラミックス、炭化珪素、炭化チタン、炭化ジルコニ

ウム等の炭化物系セラミックスを挙げることができる。これらの中でも工業的有用性が高 いという理由から窒化アルミニウム又は窒化珪素を使用するのが好適である。なお、本発 明で使用する非酸化物セラミックスは、単結晶或いは多結晶等の結晶性のもの、アモルフ ァス、又は結晶相とアモルファス層が混在するもの、さらには焼結助剤および必要に応じ て他の添加剤を添加して非酸化物セラミックス粉末を焼結した焼結体等が使用できる。ま た、その形状や大きさ等も特に限定されず、板状や異形等の任意の形状に加工された形成 体、薄膜等が使用できる。本発明においては、有用性が高く、安価で入手も容易で、本発 明の効果も高いという理由から、被処理セラミックスとしては、窒化アルミニウム或いは 窒化珪素を予め任意の所定の形状に成形焼結させた焼結体を使用するのが好適である。 【0029】

また、本発明により得られる酸化物層を有する非酸化物セラミックスを、冷却部材ある 40 いは耐プラズマ性部材として用いる場合には、予め所定の形状に加工した被処理セラミッ クス焼結体を用いることが好ましいが、被処理セラミックスのブロック体に酸化膜を形成 した後、所望の形状に加工してもよい。

【 0 0 3 0 】

たとえば、非酸化物セラミックスが窒化アルミニウム焼結体である場合には、窒化アル ミニウム粉末にイットリア、カルシア、硝酸カルシウム及び炭酸バリウムからなる群より 選ばれる少なくとも1種の添加剤を添加して定法により所定の形状に成形した後に焼結し たもの及びこれを更に加工したものが好適に使用できる。また、非酸化物セラミックスが 窒化珪素焼結体である場合には、窒化珪素粉末に酸化マグネシウム、酸化第二クロム、ア ルミナ、イットリア、ジルコニア、窒化アルミニウム、炭化珪素、ホウ素及び窒化ホウ素

(9)

からなる群より選ばれる少なくとも1種の添加剤を添加して定法により所定の形状に成形 した後に焼結したもの及びこれを更に加工したものが好適に使用できる。 【0031】

本発明において、被処理セラミックスには、表面の粗面化や研磨等の前処理を行うこと もできる。粗面化処理としてはアルカリ性水溶液によるエッチング、サンドプラスト等が 挙げられる。また研磨処理としては砥粒を用いた研磨、電解インプロセスドレッシング研 削法による研磨等を挙げることができる。また、形成される酸化物層を構成する酸化物(例えばアルミニウム酸化物や珪素酸化物)の焼結助剤となるような物質或いはその前駆体 物質を予め被処理セラミックスの表面に付着させておいてもよい。このような物質として はSiO₂、MgO、CaO、B₂O₃、Li₂O等を挙げることができる。 【0032】

本発明の製法においては、上記被処理セラミックスを炉内に導入した後、炉内雰囲気を 、 1 m³に含まれる酸化性ガスの合計モル数が 0 . 5 m m o 1 以下とする(ディーガス(d egas)処理という)。ここで、酸化性ガスとは酸素ガス、水蒸気、二酸化炭素ガス、一酸 化炭素ガス等の非酸化物セラミックスを酸化する能力を有するガスを意味する。この酸化 性ガスは、雰囲気中に含まれるガスのほか、炉材に吸着または収着しているガスも含む。 加熱時の雰囲気を大気等の酸化性ガスを多く含む雰囲気とした場合には、加熱時に被処理 セラミックス中に酸化性ガス又は酸化性ガスに由来する酸素が固溶してしまうためと思わ れるが、酸化反応時に前記したような特徴的なクラック、より具体的には「分岐を有する クラックであって、当該分岐を有するクラックを互いに隣り合った分岐点間のクラックユ ニット及び端部からその直近の分岐点までのクラックユニットに分割した場合において、 各クラックユニットの長さ及び最大幅を夫々1(nm)及びw(nm)としたときに、w が20nm以上でありIが500nm以上であり且つw/1が0.02以上となるクラッ クユニットを有する分岐を有するクラック」(以下、特定クラックともいう。)の発生が 避けられない。加熱時の雰囲気を窒素ガス等の不活性ガス雰囲気とすることにより、上記 特定クラックの発生を抑止することができるが、不活性ガス中に含まれる酸化性ガスの合 計濃度が0.5mmol/m³(0.00112vol.%)を超える場合には、酸化物 層の非酸化物セラミックスとの界面近傍に空隙が形成されてしまい、非酸化物セラミック スと酸化物層との密着強度を高くすることができない。効果の観点から、加熱時の雰囲気 中に含まれる酸化性ガスの合計濃度、特に酸素及び水蒸気の合計濃度は0.1mmol/ m³以下、特に0.01mmol/m³以下であるのが好適である。

[0033]

ここで、加熱時の雰囲気とは炉内の実際の雰囲気を意味し、昇温・加熱時に炉壁や被処 理物となる非酸化物セラミックスから放出されるガスの影響が加味されたものである。例 えば高純度不活性ガスを流通させて昇温・加熱する場合においても、予めディーガス(de gas)処理を行なわない場合には昇温・加熱時に炉壁や被処理セラミックスから酸素や水 蒸気が放出されるので不活性ガス純度は低下し、加熱時の雰囲気ガスの組成は導入したガ スの組成とは同じにはならない。この場合、加熱時の雰囲気ガスの組成は炉から流出した ガスを分析することにより確認することができる。なお、本発明において、加熱開始して から被処理セラミックスの温度がさほど高くならない間は雰囲気制御を厳密に行なう必要 はないが、少なくとも被処理セラミックスの温度が100 以上、より好ましくは200 以上となる加熱過程における雰囲気は、酸化性ガスの合計濃度、特に酸素分子と水分子

以上となる加熱過程にのりる雰囲気は、酸化性ガスの言計濃度、特に酸素分子と水分子 との合計濃度が上記した範囲となるように管理する必要がある。 【0034】

本発明の製造方法では、上記のディーガス処理に次いで、前記被処理セラミックスを1 m3に含まれる酸化性ガスの合計モル数が0.5mmol以下である雰囲気を保ちながら、 被処理セラミックスの酸化開始温度より300 低い温度以上の温度に加熱する(以下 、該工程を加熱工程ともいう。)。このような雰囲気を保ちながら加熱する方法は特に限 定されないが、ディーガス処理を行なった後に炉内を純度99.999%以上、より好ま しくは99.999%以上、最も好ましくは99.9995%以上の高純度不活性ガ

20

10

スで十分に置換してから当該不活性ガスの流通下で加熱するか又は加熱時の炉内の圧力を 常に100Pa以下、好ましくは40Pa以下、最も好ましくは20Pa以下の圧力に保 って加熱するのが好適である。ディーガス処理の方法は、表面に吸着している若しくは内 部に吸収されているガスを脱離させることができる方法であれば特に限定されず、室温~ 100 の範囲で、ガスの脱離がなくなるまで減圧下で脱気するのが好適である。脱気時 の減圧度(炉内の圧力)は特に限定されないが、100Pa以下、特に20Pa以下であ るのが好適であり、1Pa以下とするのが最も好ましい。また、脱気と不活性ガス置換を 複数回行うことが好ましい。

(11)

[0035]

10 なお、本発明の製造方法においては、被処理セラミックスの酸化が開始されるまでは被 処理セラミックス中に酸化性ガス又は酸化性ガスに由来する酸素を実質的に拡散させない ことが重要である。このためには酸化反応開始温度までは上記のような雰囲気中で加熱す るのが好ましいが、少なくとも被処理セラミックスの酸化開始温度より300 低い温度 に加熱した場合には、系内(炉内)に酸素ガスを導入しても昇温速度を制御することによ り(実用的に制御可能な昇温速度の範囲、例えば10~80 /分、好ましくは30~5 /分で昇温しても)問題となるような酸素の拡散を起さず、且つ被処理セラミックス 0 に大きなダメージを与えることなく酸化反応開始温度まで昇温することが可能である。加 熱温度が被処理セラミックスの酸化開始温度より300 を超えて低い温度である場合、 酸化物層の形成に悪影響を及ぼす酸素等の拡散を起すことなく被処理セラミックスを酸化 開始温度に昇温するためには昇温速度を速くしなければならず、被処理セラミックスの形 20 状によってはそのような速い昇温速度で昇温した場合には変形したりクラックが発生した りするという問題が生じる。用いる炉の性能や被処理物セラミックスの形状にもよるが、 被処理セラミックスは前記雰囲気中で被処理セラミックスの酸化開始温度より100 低 い温度以上の温度、特に被処理セラミックスの酸化開始温度以上の温度に加熱するのが好 適である。ここで酸化開始温度とは、酸化性ガス雰囲気下で被処理セラミックスを加熱し た場合に急激な酸化反応が開始される温度を意味し、本発明では、反応圧力下に酸素雰囲 気で被処理セラミックスを1~100 /分、好ましくは75 /分の昇温速度で加熱し たとき、被処理セラミックの酸化反応率が臨界的(critical)に変化する温度をいう。該酸 化開始温度は上記条件で被処理セラミックスを加熱する際の熱重量分析結果において急激 30 な重量変化を開始する温度又は示差熱分析結果において急激な発熱を開始する温度として 容易に特定することができる。例えば窒化アルミニウムの大気圧下における酸化開始温度 は、図1に示される様に1100 である。

[0036]

本発明の製造方法では、上記のようにして1m³に含まれる酸化性ガスの合計モル数が 0.5mmol以下である雰囲気中で被処理セラミックスの酸化開始温度より300 低 い温度以上の温度に加熱された被処理セラミックスを酸素ガスと接触させた後、当該被処 理セラミックスの酸化開始温度より高い温度に保持して当該被処理セラミックス基材の表 面を酸化して酸化物層を形成する(該工程を酸化工程ともいう。)。

[0037]

40 このとき、酸化物層と非酸化物セラミックスとの界面に気泡や空隙等の欠陥が発生しな いようにするために、昇温中の雰囲気を高度に制御することに加えて、被処理セラミック スを酸化性ガスと接触させる際に、接触を開始してから所定の期間(以下、接触初期期間 ともいう。)の雰囲気制御を厳密に行なうことが重要である。即ち、本発明の製造方法に おいては、被処理セラミックスと酸化性ガスとの接触を開始し、前記非セラミックスの温 度が当該非酸化物セラミックスの酸化開始温度以上となってから少なくとも2分を経過す るまでの間は、酸化性ガスの圧力または分圧を50kPa以下とする必要がある。より具 体的には、酸化開始温度以上の温度で接触を開始した場合には、接触開始から2分以上が 経過するまでの期間、酸化開始温度より低い温度で接触を開始した場合には接触を開始し てから酸化開始温度に達するまでの期間と酸化開始温度に達してから2分以上が経過する までの期間を加えた期間は、酸化性ガスの圧力または分圧を50kPa以下とする必要が 50

ある。但し、上記の接触初期期間を経過した後においては、酸化性ガスの圧力または分圧 を、上記上限値を越えて高くしても界面に欠陥が発生することはない。おそらく、界面の 構造は酸化反応開始初期に決定され、良好な状態で薄い酸化膜が形成された後は、その後 の酸化膜の成長段位においても良好な界面状態が維持されるものと考えられる。 【0038】

接触初期期間の酸化性ガスの圧力又は分圧が上記範囲を越える場合には、酸化物層と非酸化物セラミックスとの界面に欠陥が発生し、両者の接合強度が低下し、例えばヒートサイクル試験を行なった場合に酸化物層が剥離することがある。界面における欠陥発生防止効果の観点から、被処理セラミックスと酸化性ガスとの接触を開始し、前記非セラミックスの温度が当該非酸化物セラミックスの酸化開始温度以上となってから少なくとも2分を経過するまでの間は酸化性ガスの圧力または分圧を40kPa以下、特に30kPa以下とするのが好ましく、さらには酸化開始温度以上となってから少なくとも3分を経過するまでの間は酸化性ガスの圧力または分圧を55kPa以下、特に50kPa以下とするのが好ましい。

【 0 0 3 9 】

前記酸化工程において、所定の温度に加熱された被処理セラミックスを酸化性ガスと接触させる場合には、被処理セラミックスの温度をモニターし、その温度が所定の温度に達したことを確認した後に炉内に所定の圧力の酸化性ガス或いは、酸化性ガスを不活性ガスで希釈した混合ガスでであって酸化性ガスの分圧が所定値となるように調整されたガスを を導入し、これらガスの存在下で被処理セラミックスを酸化開始温度以上の温度で所定時間以上保持し、必要に応じて酸化性ガスの圧力又は分圧を高くすればよい。このとき、接触初期期間中における酸化性ガスの圧力又は分圧は一定であっても変動していてもよいが、界面における欠陥発生防止効果の観点から、その上限値を越えない範囲で時間の経過に 伴って0Paから段階的又は連続的に高くして行くのが好適である。また、非処理セラミックスが複雑な形状を有し、その複雑な形状の表面を酸化処理したい場合には、非処理セラミックスと酸化性ガスの接触をよくするために酸化性ガス又は酸化性ガスを含むガス(以下酸化用ガスともいう。)の圧力を揺動させるのが好適である。

【0040】

また、加熱工程において不活性ガスの流通下において加熱を行なった場合、不活性ガス の導入を停止し、替わりに酸化性ガスを導入しても炉内の雰囲気は直ちに酸化性ガスに置 換されることはないので、導入する炉内のスペースやガスの流通状態を考慮して酸化性ガ スの流量を制御することにより接触初期期間における酸化性ガスの分圧制御を行なうこと も可能である。しかしながら、この場合には、ガスの導入個所や炉内の構造によってガス の拡散は影響を受け、局所的に酸化性ガス分圧が高くなることがあるので注意が必要であ る。

[0041]

被処理セラミックスと酸化性ガスとの接触を開始する温度は被処理セラミックスの酸化 開始温度より300 低い温度以上の温度であれば、良好な酸化物層を形成することがで きるが、より確実に良好な酸化物層が得られるという理由から、被処理セラミックスの酸 化開始温度より100 低い温度以上の温度、特に被処理セラミックスの酸化開始温度以 上の温度であるのが好適である。

【0042】

上記酸化工程で被処理物セラミックスを酸化するために使用する酸化性ガス又は酸化性 ガスを含むガス(酸化用ガス)としては、前記した酸化性ガスが特に制限なく使用できる が、得られる酸化物層に欠陥が少ないという観点から露点が - 5 0 以下のガスを使用す るのが好適であり、 - 7 0 以下の露点を有するものを使用するのが最も好ましい。たと えば、超高純度酸素ガス、超高純度一酸化炭素ガス、超高純度二酸化炭素ガス、これらの 混合ガス、これら超高純度ガスを超高純度不活性ガスで希釈した混合ガス、脱水処理した 空気等が好適に使用できる。

【0043】

10

20

酸化用ガス中の酸化性ガス濃度は、酸化物層の形成速度に影響を与え、一般に酸素濃度 が高いほど酸化物層の形成速度は速くなる。このため、効率の観点から、接触初期期間経 過後は、酸化用ガスとして酸素濃度が50vol.%以上、特に99vol.%以上のも のを用いるのが好適である。

(13)

【0044】

酸化工程においては、被処理セラミックスを酸化開始温度以上の温度で酸化用ガスと接触させる必要があるが、酸化温度が高すぎる場合にはエネルギーコストが高くなるばかり でなく酸化物層の厚さの制御が困難となるので酸化開始温度より500 高い温度以下、 特に酸化開始温度より300 高い温度以下とするのが好適である。また、酸化時間は、 使用する酸化用ガスの酸素濃度、酸化温度及び得ようとする酸化物層の厚さに応じて適宜 決定すればよい。例えば厚さ1000~3000nmの - アルミナ層を有する窒化アル ミニウムを得るためには、通常0.5~50時間酸化開始温度より高い温度で保持すれば よい。なお、酸化工程で形成される酸化物層は被処理物セラミックスである非酸化物セラ ミックスの構成成分である金属又は半金属の酸化物からなるが、該酸化物層には被処理物 セラミックスの種類に応じて窒素や炭素が固溶していてもよい。

【0045】

上記酸化処理終了後は、酸化処理された非酸化物セラミックスを冷却して炉内から取り 出せばよい。また、冷却時に非酸化物セラミックスや酸化物層が損傷しないように徐冷す るのが好適である。

[0046]

このような本発明の製造方法により得られる表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスは、非酸化物セラミックスと酸化物層の界面近傍の酸化物層に空隙若しくは気泡が実質的に存在せず非酸化物セラミックス層と酸化物層との密着強度が非常に高いという特徴を有する。本発明の製造方法により得られる表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスにおいて、その酸化物層の非酸化物セラミックスとの界面近傍における空隙若しくは気泡が実質的に存在しない領域(以下、空隙非存在領域ともいう。)は、界面からある厚さをもって酸化層の全面に広がる層状の領域であり、その厚さは酸化物層全体の層厚によらず、20~100nmの厚さである。ここで空隙若しくは気泡が実質的に存在しないとは、上記空隙非存在領域における空隙率(該領域の全体に占める空隙の体積の割合)が5%以下、好ましくは3%以下、特に好ましくは1%以下であることを意味する。上記空隙非存在領域以外の酸化物層領域、特に表層近傍を除く領域には径が50~100nm程度の大きさの空隙が多く見られるのに対し、該空隙非存在領域ではそのような空隙が殆ど見られず、空隙があったとしてもその径が5nm以下、好ましくは1nm以下のものが殆どである。なお、酸化物層の表層部分については、酸化物層の厚さが厚くなると、空隙が減少し、径が大きくなる傾向が見られる。

【0047】

また、非酸化物セラミックスが非酸化物セラミックス焼結体である場合には、焼結体製 造時に焼結助剤の結晶が表面に析出することがあることはよく知られた事実である。本発 明の製造方法によりこのような焼結体を酸化した場合、焼結助剤の結晶と非酸化物セラミ ックス焼結体の粒界でも酸化反応が進行し、析出した焼結助剤結晶直下の非酸化物セラミ ックスも酸化される。しかもその部分の酸化物層と非酸化物セラミックス焼結体との界面 には気泡や空隙のといった欠陥がみられない。このことは、非酸化物セラミックスの表面 に少量の異物が存在する場合でも、酸化物層がその異物を包み込み異物による悪影響を受 け難いということを示唆するものであり、本発明の方法はこの点でも価値がある。

【0048】

空隙非存在領域の存在は、試料の断面を透過型電子顕微鏡(TEM)観察することにより確認することができる。この場合、空隙は、TEM写真において白い若しくは薄い色のゆがんだ楕円状(場合によっては多角形の形状に見えることもある)の模様として観察されるが、観察試料の厚さが不均一である場合には判別が困難である。このため、TEM観察を行なう場合の試料の厚さは50~100 nmの範囲で均一な厚さとする必要がある。

10

20

このような試料の作成は、次のようにして行なうことができる。即ち、TEM観察用の試料作製に広く用いられている集束イオンビーム(FIB)装置において、加速したガリウムイオンで試料の研削を行い、試料表面から見て横幅10~20μm、縦50~100nmの領域を残すように周囲を研削する。研削領域の確認は、ガリウムイオンを照射した際に試料から発生する二次電子を検出して像を取得する走査型イオン顕微鏡(SIM)により可能である。一般的にSIMはFIB装置に付随しており、このSIM観察によって正確に研削領域を確認することができ、TEM観察を行なう場合の試料の厚さを50~10 0nmの範囲で均一な厚さとすることが可能になる。

【0049】

また、本発明の製造方法により得られる表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックス ¹⁰ は、表面に形成される酸化物層には前記したような特定クラック、即ち、「分岐を有する クラックであって、当該分岐を有するクラックを互いに隣り合った分岐点間のクラックユ ニット及び端部からその直近の分岐点までのクラックユニットに分割した場合において、 各クラックユニットの長さ及び最大幅を夫々1(nm)及びw(nm)としたときに、w が20nm以上でありIが500nm以上であり且つw/1が0.02以上となるクラッ クユニットを有する分岐を有するクラック」が実質的に存在しないという特徴も有する。 【0050】

上記特定クラックについて図を用いて更に詳しく説明すると、例えば分岐を有するクラ ック1が図2に示される様な形状を有する場合、2a~2eが各クラックユニットとなる 。そして各クラックユニットについて1、w及びw/1を求めたとき、wが20nm以上 であり」が500nm以上であり且つw/lが0.02以上、好ましくは0.01以上と なるクラックユニットが1つでも存在する場合には、この分岐を有するクラック1は特定 クラックとなる。また、w/lが0.02以上、好ましくは0.01以上のクラックユニ ットが全く存在しない場合にはその分岐を有するクラック1は特定クラックとはならない 。このような特定クラックが存在しないことは酸化物層の表面を走査型電子顕微鏡で観察 することにより確認することができる。なお、特定クラックが実質的に存在しないとは、 一つの試料について任意の視野(半径3000nmの視野)10箇所、好ましくは50 箇所を観察したときに観察される特定クラックの数が、1視野当たりの平均で0.2以下 、好ましくは0.1以下、最も好ましくは0.05以下であることを意味する。但し、下 地の非酸化物セラミックスの形状を反映し、或いは酸化膜の成長の仕方によって酸化膜の 表面に凹凸ができることはしばしばあるが、このような場合に観測される凹部はクラック ではなく、本発明に言うクラックとは、酸化物層の少なくとも表層部を不連続に切断する 割れを意味する。

【0051】

本発明の製法で得られる表面に酸化物層を有する非酸化物セラミックスは、上記したような良好な酸化物層を有するため、酸化物層を形成することにより期待される効果を十分に発揮することが可能であり、耐プラズマ性部材や冷却装置の冷却部材など様々な用途に好適に使用できる。たとえば、0.1~100µm、好適には1~50µmの酸化物層を有する窒化物セラミックス(特に窒化珪素)からなる、自動車エンジン部材等の構造材料は、従来酸化法により酸化膜を形成したものよりもより強度が高く、その耐久性も高いものとなる。さらに、本発明の製造方法で得られる表面に酸化物層を有する窒化物セラミックス粉末を用いてグリーン体を形成し、得られたグリーン体を焼成することにより得られる焼結体も従来酸化法で酸化膜を形成した窒化物セラミックス粉末を用いた場合よりも、その強度や耐水性が高いものとなる。

[0052]

本発明の冷却装置は、冷却ジャケットが、上記した酸化物層を有する非酸化物セラミックスからなる部材で構成されている他は従来の冷却装置(標準構成冷却装置)と特に変わる点はなく、発熱体と、非酸化物セラミックス部材からなる冷却ジャケットと、冷却媒供給手段を備え、前記発熱体と前記冷却ジャケットは熱的に接触すると共に該冷却ジャケットの少なく

30

20

とも前記冷却媒と接触する面の表面には酸化物層が形成されている。以下、図面を参照し て本発明の冷却装置について説明する。

【0053】

図19に本発明の代表的な冷却装置100の冷却系統図を示す。図19に示される冷却 装置は半導体素子や集積回路等の発熱体Bを冷却する発熱体冷却ユニット(I)と冷却媒 供給ユニット(II)の2つのブロックからなる。発熱体冷却ユニット(I)では、基板A 上に複数の発熱体Bが搭載されており、この発熱体B上には、冷却媒C(例えば水)の供 給を受けて発熱体Bを冷却する冷却ジャケットDが設けられている。該ジャケットDは発 熱体Bと熱的に接触すると共にその内部に冷却媒Cが通過する流路(空洞)が設けられて いる。冷却媒としては通常の冷却装置で冷却媒として使用されている液体が特に制限無く 使用できるが、管理の容易さから水又は水と水溶性有機溶媒の混合液を使用するのが好適 である。水溶性有機溶媒としては、エチレングリコール、エタノール等が好適に使用でき る。

【0054】

冷却媒供給ユニット(II)は、冷却ジャケットDに発熱体を冷却するための冷却媒Cを 供給するための手段として機能し、タンクF、ポンプG等の冷却媒移送手段及び熱交換器 Hを有している。発熱体冷却ユニット(I)と冷却媒供給ユニット(II)は配管Eにより 接続されている。冷却媒Cは、冷却媒供給ユニット(II)においてタンクFから出た後、 ポンプGで加圧され、発熱体冷却ユニット(I)に送られる。さらに伝熱性媒体Cは、冷 却ジャケットDにおいて発熱体Bを冷却した後に、冷却媒供給ユニット(II)に戻り、熱 交換器Hにより再度冷却される。なお、図19では熱交換器HはジャケットDからタンク Fに戻るラインの途中に設置したが、その設置位置は特に限定されない。また、図示しな いが、熱交換器HとタンクFとは一体となったものであってもよい。更に、熱交換器が十 分な冷却能力を有するのであれば、タンクFを設ける必要は特に無い。 【0055】

本発明の冷却装置においては、冷却ジャケットが冷却媒との接触により劣化することが 無いので、発熱体冷却ユニット(II)に冷却媒中のイオンを除去するための装置を設置す る必要は特に無いが、長期間使用すると冷却媒の変質により冷却効率が低下することがあ るので、冷却媒の状態を一定の範囲に保つための手段を有するのが好適である。このよう な手段としては、定期的に或いは連続的に冷却媒の一部または全部を新しい冷却媒に入れ 替える手段、または定期的に或いは連続的に冷却媒の一部または全部を精製する手段等が 挙げられる。

[0056]

本発明の冷却装置の最大の特徴は、前記冷却ジャケットを本発明に係る酸化物層を有す る非酸化物セラミックスからなる部材で構成した点にある。本発明に係る酸化物層を有す る非酸化物セラミックスの酸化物層は欠陥が少ない高品位なものであり、下地の非酸化物 セラミックスと水等の冷却媒との接触を遮断し該非酸化物セラミックスを有効に保護する 。しかも、非酸化物セラミックスと酸化物層との界面には欠陥がないため、耐ヒートサイ クル性が高く、冷却装置の稼動・停止を繰り返えしてもその性能が低下することがない。 該酸化物層の厚さは特に限定されないが、基材保護効果及び熱伝導性の観点から0.1~ 100µm、特に0.5~50µm、さらには0.8~10µmであるのが好適である。 【0057】

次に本発明に係る耐プラズマ性部材について説明する。本発明の耐プラズマ性部材は、 上記した酸化物層を有する非酸化物セラミックスからなる。耐プラズマ性部材は、少なく とも一部の面がプラズマに曝される環境で使用される部材であれば制限なく適用でき、該 酸化物層が形成された面を上記プラズマに曝される面として使用される。プラズマを生成 させる気体としては、酸素、アルゴン、窒素、ヘリウム等の公知のものが制限なく採用で きる。具体的には、プラズマ重合装置、プラズマ溶射装置、プラズマエッチング装置等の チャンバー内にマイクロ波、ミリ波等の10MHz~300GHz、特に1~100GH zの高周波を導入してプラズマを生成させる装置のチャンバー構成部材として使用される 10

20

【0058】

好適には、半導体や液晶の製造プロセスにおける、半導体ウェハや液晶用ガラス基板な どのウェハに薄膜を形成したり、エッチング加工を施したりする工程で使用される、プラ ズマ生成機構を備えた製造装置のチャンバー構成部材であるのが好ましい。これらの装置 では、プラズマは、通常、ハロゲン系腐食性ガスの存在下で生成させられるため、上記プ ラズマに曝されることによるチャンバー構成部材の劣化の問題は大きく促進され、腐食に よる部材表面でのパーティクルの発生や、さらに腐食が進んだ時の形状変化が激しく生じ るため、本発明の効果がより顕著に発揮される。

(16)

【0059】

10

こうしたプラズマ生成機構を備えた半導体または液晶製造装置におけるチャンバー構成 部材の中でも、ウェハを保持するためにサセプタや静電チャックなどのウェハ保持器に適 用するのが特に好ましい。ここで、サセプタは、円盤状をした基体からなり、上記基体の 保持面にウェハを載置するとともに、リング状をしたクランプリングでもってウェハの周 縁部を押さえ付けて保持するようにしたものであり、また、静電チャックは、円盤状をし た基体の内部に電極を埋設したもので、上記基体の保持面にウェハを載置し、ウェハと電 極との間に電圧を印加することで、ウェハを保持面上に静電吸着させて保持するようにし たものである。

【 0 0 6 0 】

また、上記チャンバー構成部材としては、プラズマを生成させるための高周波導入用窓 20 材も、該部材はプラズマの影響を特に受けやすいため好適である。その他、上記チャンバー構成部材としては、高周波結合アンテナ、チャンバー内の監視窓、チャンバー内の内壁 材等としても良好に使用できる。

なお、本発明に係る耐プラズマ性部材においても、非酸化物セラミックスと酸化物層と の界面には欠陥がないため、その優れた効果が長期間持続する。

【0061】

以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限 定されるものではない。

【0062】

実施例1

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム焼結体基板(株式会社トクヤマ製SH15)を内径75mm、長さ1100mmのムライトセラミックスを炉心管とする高温雰囲気炉(株式会社モトヤマ製スーパーバーン改造型)内に導入し、炉内をロータリー真空ポンプにて50Pa以下に減圧した後、窒素ガス(純度99.9995%、露点-80)で復圧置換し、流速2(1/分)の窒素流通下で1200 まで昇温した(昇温速度:3.3 /分)。基板付近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、次いで酸素ガス(純度99.999%、露点-80)を流速1(1/分)で流通させ、そのまま1時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し、本発明の表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(降温速度3.3 /分)。

昇温開始と同時に炉から排出されるガスをガスクロマトグラフ(島津製作所製パーソナ ルガスクロマトグラフGC-8A、検出器:TCD、カラム:ジーエルサイエンス株式会 社製SUS3 ×2m、充填剤モレキュラーシーブ13X-S 60/80)に導入し、 ガス成分を経時的に分析した。昇温時にはいずれの温度領域においても窒素以外の成分は 検出されなかった。酸素を流通させ始めてから10分経過したところで排ガスを分析した ところ、流通ガスである酸素の他、反応過程で生成したと考えられる窒素が検出された。 また、窒素のピークは酸素流通開始後が最も高く、温度保持時間が経過するにつれて減少 した。窒素のピークの減衰パターン及び別途作成した校正曲線(キャリブレーッションカ ーブ)から酸素を導入し始めてから2分後及び3分後の試料近傍における酸素ガスの分圧 30

(17)

【0064】

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、 X線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析を行った。各種分析の詳細を以下に示す。

【0065】

〔XRDによる反応生成物の同定〕

該試料についてX線回折装置(理学電機株式会社製X線回折装置RINT1200)を 用いてXRD測定を行ったところ、その回折パターンから該試料の酸化物層は - アルミ ナであることが確認された。なお測定は、入射X線Cu-K 線、管電圧40kV、管電 流40mA、受光スリット0.15mm、モノクロ受光スリット0.60mmで行った。 【0066】

S E M による表面観察〕

該試料をダイヤモンドカッターにて5mm×5mmに切断した後、酸化面を上にして観察用試料台にカーボンテープを用いて固定した。これをイオンスパッタリング装置(日本電子株式会社製マグネトロンスパッタリング装置JUC-5000)を用いてPtコーティングし、FE-SEM(日本電子株式会社製フィールドエミッション走査電子顕微鏡JSM-6400)にて該試料表面の観察を行った。観察は加速電圧15kV、プロープ電流5×10⁻¹¹A、エミッション電流8µA、倍率10,000倍で行い、任意の視野を50視野観察し、同箇所を写真撮影した。典型的な写真を図3に、そのイラストを図4に示す。図3に示される様に、酸化物層の表面には隆起による筋状の模様は観察されたがクラックは観察されなかった。なお、任意の視野(半径30000nmの視野)50箇所の何れの視野においても特定クラックは観測されなかった。また、試料の破断面のSEM観察により酸化物層の厚さを求めたところ、その厚さは平均で900nmであった。

〔TEMによる酸化物層の断面観察〕

FEI社製電界放射型透過型電子顕微鏡(TECNAI F20)にて、加速電圧20 0kV、スポットサイズ1、Gun Lens1、対物絞り100µmで観察した。観察 倍率は50000倍にて酸化物層と窒化物セラミックの界面付近の観察を行い、同箇所を 写真撮影した。典型的な写真を図5に、そのイラストを図6に示す。図5に示される様に 、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは空隙)が観測されたが、酸化物層の下地との界面 近傍には平均厚さ48nmの「気泡が実質的に存在しない領域(層)」が確認された。な お、試料の作成は以下に示す方法で行なった。

【0068】

〔TEMによる酸化膜の断面観察のための試料作製〕

株式会社ディスコ製ダイシング装置(DAD320)を用いて試料を試料表面から見て 横1mm、縦50μmの直方体の形状に切断し、エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会 社製集束イオンビーム装置(SMI2200)にて、断面観察のための加工を行った。加 速電圧は全て30kVで行った。走査型イオン顕微鏡(SIM)で直方体状の試料表面を 観察しながら、縦50μmを70mmになるまで周囲を研削した。研削する横幅は任意で あるが、今回は20μmとした。研削する深さは、試料断面のSIM観察で酸化物層全体 と窒化物セラミックの一部(約1μm)が観察できる深さに設定した。

【 0 0 6 9 】

〔耐アルカリ性試験〕

上記で作成した試料を、所定のサイズに切断し、酸化層の一部が露出するようにフッ素 樹脂製のシールテープで覆い(露出面積S=10mm×10mm=100mm²=100 ×10⁻⁶m²)、露出部以外は液に触れないようにして30 の5%水酸化ナトリウム水 溶液に5時間浸漬し(以下、アルカリ浸漬試験という)、浸漬前後の乾燥重量を測定した ところ、浸漬前の乾燥重量をWbは1376(mg)であり、浸漬後の乾燥重量をWaは 10

20



1 3 7 5 (mg)であった。これらの値に基づいて計算される"浸漬による単位面積当た りの乾燥重量の減少量"(単に重量減少ともいう)は20(g/m²)であった。 【0070】

なお、参照実験として表面酸化処理を施していない窒化アルミニウム基板について同様の試験を行なったところ、重量減少は113(g/m²)であった。

〔ヒートサイクル試験後のテープピール試験〕

上記アルカリ浸漬試験を行なった試料をエスペック株式会社製の耐熱衝撃性試験機TS V-40Sにて-50 125 -50 (暴露時間:10分)のサイクルを1サイ クルとする試験(以下、ヒートサイクル試験という)を1000サイクル行った。その後 、試験後の基板の酸化物層上にサーキットテープ(寺岡製作所製PTC647)を18m m×30mm貼付けた後、垂直方向へ剥がす試験(以下、テープピール試験という)を行 い、テープと基板の剥離面を実体顕微鏡(オリンパス株式会社製SZ-40)にて40倍 に拡大して観察したところ、試料組織の脱落は認められなかった。

【0072】

実施例 2

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0 .05 µ m 以下である窒化アルミニウム基板 (株式会社トクヤマ製 S H 1 5)を実施例 1 と同装置を用い、保持時間を10時間に変更する以外は全て実施例1と同じ条件で酸化し 、本発明の表面酸化窒化アルミニウム基板を得た。得られた表面酸化窒化アルミニウム基 板(試料)について、実施例1と同様にX線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析を行った。その結果、XRD測定の回折 パターンから該試料の酸化物層は - アルミナであることが確認された。また、SEMに よる表面観察結果を図7(写真)および図8(図7のイラスト)に、TEMによる酸化物 層の断面観察結果を図9(写真)および図10(図9のイラスト)に示す。図7に示され る様に、酸化物層の表面には隆起による筋状の模様は観察されたがクラックは観察されな かった。また、任意の視野(半径30000mmの視野)50箇所について同様の観察を したが、何れの視野においても特定クラックは観測されなかった。また、図9に示される 様に、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは空隙)が観測されたが、酸化物層の下地との 界面近傍には平均厚さ60nmの「気泡が実質的に存在しない領域(層)」が確認された 。なお、酸化物層の厚さは平均で3600nmであった。また、製作した試料について実 施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒートサイクル試験後のテープピール試験を行 った。その結果、アルカリ浸清試験における基板の重量減少は10(g/m²)であり、 テープピール試験では試料組織の脱落は認められなかった。

[0073]

実施例3

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を実施例1と同じ装置を用い、実施例1と同じ条件で1200 まで昇温した。基板付近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、代わりに窒素ガス(純度99.9995%、露点-80)と酸素ガス(純度99.999%、露点-80)を酸素ガス分圧が10kPaとなるように混合した酸化性ガスを流速1(1/分)で流通させ、そのまま50時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し、本発明の表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(降温速度3.3 /分)。

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析 を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから該試料の酸化物層は - アルミナで あることが確認された。SEMによる表面観察では、酸化物層の表面には隆起による筋状 の模様は観察されたがクラックは観察されなかった。また、任意の視野(半径30000 10

20

30

nmの視野)50箇所について同様の観察をしたが、何れの視野においても特定クラック は観測されなかった。TEMによる表面観察では、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは 空隙)が観測されたが、酸化物層の下地との界面近傍には平均厚さ53nmの「気泡が実 質的に存在しない領域(層)」が確認された。なお、酸化物層の厚さは平均で800nm であった。また、製作した試料について実施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒー トサイクル試験後のテープピール試験を行った。その結果、アルカリ浸漬試験における基 板の重量減少は20(g/m²)であり、テープピール試験では試料組織の脱落は認めら れなかった。

【0075】

実施例 4

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を実施例1 と同じ装置を用い、実施例1と同じ条件で1200 まで昇温した。基板付近温度が12 00 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、代わりに窒素ガス(純度99.9995%、露点-80)と酸素ガス(純度99.999%、露点-80)を酸 素ガス分圧が10kPaとなるように混合した酸化性ガスを流速1(1/分)で流通させ ながら10分間保持し、さらに酸素ガス分圧を段階的に50kPaまで引き上げて、その まま5時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し 、本発明の表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(降温速度3.3 /分)。

【0076】

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析 を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから該試料の酸化物層は - アルミナで あることが確認された。SEMによる表面観察では、酸化物層の表面には隆起による筋状 の模様は観察されたがクラックは観察されなかった。また、任意の視野(半径30000 nmの視野)50箇所について同様の観察をしたが、何れの視野においても特定クラック は観測されなかった。TEMによる表面観察では、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは 空隙)が観測されたが、酸化物層の下地との界面近傍には平均厚さ47nmの「気泡が実 質的に存在しない領域(層)」が確認された。なお、酸化物層の厚さは平均で2500n mであった。また、製作した試料について実施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒ ートサイクル試験後のテープピール試験を行った。その結果、アルカリ浸漬試験における 基板の重量減少は20(g/m²)であり、テープピール試験では試料組織の脱落は認め られなかった。

[0077]

実施例 5

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を実施例1 と同じ装置を用い、実施例1と同じ条件で1200 まで昇温した。基板付近温度が12 00 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、代わりに窒素ガス(純度99 .99995%、露点-80)と酸素ガス(純度99.999%、露点-80)を酸 素ガス分圧が10kPaとなるように混合した酸化性ガスを流速1(1/分)で流通させ ながら10分間保持し、その後は純酸素ガスに切り替えてそのまま5時間保持して窒化ア ルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し、本発明の表面酸化窒化ア ルミニウム基板を得た(降温速度3.3 /分)。

【0078】

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析 を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから該試料の酸化物層は - アルミナで あることが確認された。SEMによる表面観察では、酸化物層の表面には隆起による筋状 の模様は観察されたがクラックは観察されなかった。また、任意の視野(半径30000

20

10

nmの視野)50箇所について同様の観察をしたが、何れの視野においても特定クラック は観測されなかった。TEMによる表面観察では、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは 空隙)が観測されたが、酸化物層の下地との界面近傍には平均厚さ49nmの「気泡が実 質的に存在しない領域(層)」が確認された。なお、酸化物層の厚さは平均で3200n mであった。また、製作した試料について実施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒ ートサイクル試験後のテープピール試験を行った。その結果、アルカリ浸漬試験における 基板の重量減少は10(g/m²)であり、テープピール試験では試料組織の脱落は認め られなかった。

[0079]

実施例7(実施例7は参考例である。)

長さ25.4mm、幅25.4mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.1µm以下である窒化珪素基板(電気化学工業株式会社製デンカSNプレート)を実施例1と同装置を用い1400 にて24時間酸化し、本発明の表面酸化窒化珪素基板を得た。このとき、昇温開始と同時に炉から排出されるガスを実施例1と同装置を用いガス成分を経時的に分析した。昇温時にはいずれの温度領域においても窒素以外の成分は検出されなかった。酸素を流通させ始めてから10分経過したところで排ガスを分析したところ、流通ガスである酸素の他、反応過程で生成したと考えられる窒素が検出された。窒素の ピークは酸素流通開始後が最も高く、温度保持時間が経過するにつれてやや減少した。

得られた表面酸化窒化珪素基板(試料)について、実施例1と同装置、同測定条件でX 20 RD測定を行ったところ、その回折パターンから該試料の酸化物層はクリストバライトであることが確認された。また該試料表面を実施例1と同装置、同試料作製方法、同観察条件で該試料表面SEM観察を行ったところ、任意の50視野において特定クラックは存在せず、極めて緻密な酸化層であることが判明した。さらに実施例1と同装置、同試料作製方法、同観察条件で該試料酸化物層の断面TEM観察を行ったところ、窒化珪素界面と酸化物層との界面近傍に約40nmの厚さの空隙非存在領域が存在することが判明した。 【0081】

比較例1及び2(従来酸化の例)

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を内径75mm、長さ1100mmのムライトセラミックスを炉心管とする高温雰囲気炉(株式外会社モトヤマ製スーパーバーン改造型)内に導入し、流速2(1/分)のdry-air流通下で1200 まで昇温した(昇温速度:3.3 /分)。基板付近温度が1200 に達したのを確認してからそのまま1時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し(降温速度3.3 /分)、表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(比較例1)。また、保持時間を10時間に変更する以外は全て比較例1と同じ条件で酸化し、表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(比較例2)。

【0082】

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析
40
を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから何れの試料の酸化物層とも - アルミナであることが確認された。また、酸化物層の厚さは比較例1の試料が平均で1500
nmであり、比較例2の試料が平均で18000nmであった。また、比較例1の試料の
SEMによる表面観察結果を図11(写真)および図12(図11のイラスト)に、比較例2の試料のSEMによる表面観察結果を図13(写真)および図14(図13のイラスト)に示す。また、図11および図13に示される様に、両試料の酸化物層表面には隆起による筋状の模様の他に特定クラックが観察された。因みにSEM写真に基づいて各試料の酸化物層表面に存在するクラックについて最も大きなw/1を示すクラックユニットにおけるw、1及びw/1は、比較例1の試料ではw=120nm、1=880nm、w/1=0

10

.18であった。また、任意の視野(半径30000nmの視野)50箇所について同様 の観察をしたところ、比較例1については合計35個、比較例2については合計38個の 特定クラックが観測された。また、比較例1の試料のTEMによる表面観察結果を図15 (写真)および図16(図15のイラスト)に、比較例2の試料のTEMによる表面観察結 果を図17(写真)および図18(図17のイラスト)に示す。図15及び17に示され る様に、何れの酸化物層には楕円状の気泡(若しくは空隙)が観測された。そして、実施 例1及び2とは異なり、何れの試料においても気泡は酸化物層の下地との界面近傍にも確 認された。

【0083】

また、製作した試料について実施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒートサイク 10 ル試験後のテープピール試験を行った。その結果、アルカリ浸漬試験における試料の重量 減少は比較例1で103(g/m²)、比較例2で85(g/m²)であり、テープピール 試験では何れの場合も試料組織の脱落が認められた。

【0084】

比較例3(ディーガス処理なしの新酸化法の例)

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を内径75mm、長さ1100mmのムライトセラミックスを炉心管とする高温雰囲気炉(株式外会社モトヤマ製スーパーバーン改造型)内に導入し、流速2(1/分)の窒素ガス(純度99.9995%、露点-80)、窒素流通下で1200 まで昇温した(昇温速度: 3.3 /分)。基板付近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、代わりに酸素ガス(純度99.999%、露点-80)を流速1(1/分)で流通させ、そのまま1時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し、本発明の表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(降温速度3.3 /分)。

[0085]

昇温開始と同時に炉から排出されるガスをガスクロマトグラフ(島津製作所製パーソナ ルガスクロマトグラフGC-8A)に導入し、ガス成分を経時的に分析した。昇温時には 窒素の他、微量の酸素及び水が検出された。別途作成した検量線を用いて、基板温度が3 00 に達したときに排出されたガス中の酸素及び水の量を定量したところ酸素及び水の 濃度は、酸素が1.2mmol/m³(0.0027vol.%)であり、水が1.0m mol/m³(0.0022vol.%)であった。両方の和が0.5mmol/m³を超 えたことで酸化物層の下地との界面近傍に気泡(若しくは空隙)が発生したものと考えら れる。また、酸素を流通させ始めてから10分経過したところで排ガスを分析したところ 、流通ガスである酸素の他、反応過程で生成したと考えられる窒素が検出された。窒素の ピークは酸素流通開始後が最も高く、温度保持時間が経過するにつれてやや減少した。 【0086】

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析 を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから何れの試料の酸化物層とも - アル ミナであることが確認された。また、試料表面SEM観察を行ったところ、特定クラック は存在せず、極めて緻密な酸化物層であることが判明した。さらに酸化物層の断面TEM 観察を行ったところ、酸化物層全体にわたり空隙若しくは気泡が存在することが確認され た。すなわち、窒化アルミニウム層との界面から20nm以下の厚さの領域における酸化 物層の気泡率は10%であった。

【0087】

また、製作した試料について実施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒートサイク ル試験後のテープピール試験を行った。その結果、アルカリ浸漬試験における試料の重量 減少は30(g/m²)であり、テープピール試験では試料組織の脱落が認められた。 【0088】 20

比較例4(ディーガス処理なしで、且つ接触初期期間の酸素分圧が本発明の規定の範囲 外である新酸化法の例)

長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を実施例1と同じ装置を用い、ディーガス処理を行なうことなく流速2(1/分)の窒素ガス(純度99.9999995%、露点-80)流通下で1200 まで昇温した(昇温速度:3. (分)。基板付近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、炉内をロータリー真空ポンプにて50Pa以下に減圧した後、酸素ガス(純度99.99%、露点-80)で大気圧まで急激に復圧置換し、流速2(1/分)で流通させ、そのまま5時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し(降温速度3.3 /分)、表面酸化窒化アルミニウム基板を得た。

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析 を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから何れの試料の酸化物層とも - アル ミナであることが確認された。また、酸化物層の厚さは平均で3500nmであった。S EMによる表面観察より、酸化物層表面には隆起による筋状の模様の他に特定クラックで はないクラックが観察された。また、試料のTEMによる断面観察より、何れの酸化物層 には楕円状の気泡(若しくは空隙)が観測された。そして、実施例1、2及び3とは異な り、気泡は酸化物層の下地との界面近傍にも確認された。また、製作した試料について実 施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及びヒートサイクル試験後のテープピール試験を行 った。その結果、アルカリ浸漬試験における試料の重量減少は60(g/m²)であり、 テープピール試験では試料組織の脱落が認められた。

[0090]

比較例5(接触初期期間の酸素分圧が本発明の規定の範囲外である新酸化法の例)
長さ50.8mm、幅50.8mm、厚さ0.635mmの板状で、表面粗さRaが0.05µm以下である窒化アルミニウム基板(株式会社トクヤマ製SH15)を実施例1
と同じ装置を用い、実施例1と同じ条件で1200 まで昇温した。基板付近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、炉内を再びロータリー真空ポンプにて50Pa以下に減圧した後、酸素ガス(純度99.999%、露点-80)で大気圧まで急激に復圧置換し、流速2(1/分)で流通させ、そのまま5時間保持して窒化アルミニウム基板の表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し(降温速度3.3 /分)、表面酸化窒化アルミニウム基板を得た(比較例5)。

【0091】

得られた表面酸化窒化アルミニウム基板(試料)について、実施例1と同様にX線回折 (XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析 を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから何れの試料の酸化物層とも - アル ミナであることが確認された。また、酸化物層の厚さは比較例5の試料が平均で3100 nmであった。SEMによる表面観察より、両試料の酸化物層表面には隆起による筋状の 模様の他に特定クラックではないクラックが観察された。また、試料のTEMによる筋面 観察より、何れの酸化物層には楕円状の気泡(若しくは空隙)が観測された。そして、実 施例1、2及び3とは異なり、何れの試料においても気泡は酸化物層の下地との界面近傍 にも確認された。また、製作した試料について実施例1と同様にしてアルカリ浸漬試験及 びテープピール試験を行った。その結果、アルカリ浸漬試験にける試料の重量減少は比較 例5で50(g/m²)であった。さらに、テープピール試験では試料組織の脱落が認め られた。

【0092】

実施例 8

窒化アルミニウム粉末((株)トクヤマ製、Hグレード)100重量部、焼結助剤とし て酸化イットリウム微粉末5重量部及び有機バインダーとしてアクリル酸メチルエステル ⁵⁰

10

20

30

4 重量部より成る組成物を圧力500kg/cm²で1軸プレス成形することにより、直 径360mm、厚み16mmのグリーン体を得た。

[0093]

このように得られたグリーン体を脱脂して有機バインダーを除去した後、窒化ホウ素製 の密閉型焼成容器に入れ、窒素雰囲気中、1850の条件で焼成して、相対密度98% 以上、177W/m・Kの緻密な窒化アルミニウム焼結体を得た。

窒化アルミニウム焼結体の熱伝導率は、理学電機(株)製の熱定数測定装置PS-7を 使用して、レーザーフラッシュ法により測定した。厚み補正は検量線により行った。 [0094]

10 得られた窒化アルミニウム焼結体を加工し、直径160mm、厚み5mm、ウェハ搭載 面の表面粗さがRa=0.05μm以下、その他の加工面の粗さがRa=0.8μmであ り、周縁に3ヶのピン穴が形成された円形の窒化アルミニウム製サセプタ(ウェハ保持器)を得た。

[0095]

このサセプタを、内径200mm、長さ1100mmのムライトセラミックスを炉心管 とする高温雰囲気炉内に、ウェハ搭載面を上に向けて導入し、炉内をロータリー真空ポン プにて50Pa以下に減圧した後、窒素ガス(純度99.99995%、露点-80) で復圧置換し、流速2(1/分)の窒素流通下で1200 まで昇温した(昇温速度:3 /分)。基板付近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停 . 3 止し、次いで酸素ガス(純度99.999%、露点-80)を流速1(1/分)で流通 させ、そのまま1時間保持してサセプタの表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し(降温速度3.3 /分)、本発明の表面酸化窒化アルミニウム製サセプタを得た。

20

30

[0096]

昇温開始と同時に炉から排出されるガスをガスクロマトグラフ(島津製作所製パーソナ ルガスクロマトグラフGC-8A、検出器:TCD、カラム:ジーエルサイエンス株式会 社製SUS3 ×2m、充填剤モレキュラーシーブ13X-S 60/80)に導入し、 ガス成分を経時的に分析した。昇温時にはいずれの温度領域においても窒素以外の成分は 検出されなかった。酸素を流通させ始めてから10分経過したところで排ガスを分析した ところ、流通ガスである酸素の他、反応過程で生成したと考えられる窒素が検出された。 また、窒素のピークは酸素流通開始後が最も高く、温度保持時間が経過するにつれて減少 した。窒素のピークの減衰パターン及び別途作成した校正曲線(キャリブレーッションカ ーブ)から酸素を導入し始めてから2分後及び3分後の試料近傍における酸素ガスの分圧 を求めたところ、2分後の分圧は22kPaであり、3分後の分圧は39kPaであった

[0097]

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタ(試料)のウェハ搭載面について、X線 回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて 分析を行った。

[0098]

40 図20に典型的なSEM写真を示し、そのイラストを図21に示す。図20に示される 様に、酸化物層の表面には隆起による筋状の模様は観察されたがクラックは観察されなか った。なお、他の何れの視野においても特定クラックは観測されなかった。また、試料の 破断面のSEM観察により酸化物層の厚さを求めたところ、その厚さは平均で1000n mであった。

[0099]

図22に酸化物層と窒化物セラミックの界面付近の典型的な写真を示し、そのイラスト を図23に示す。図22に示されるように、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは空隙) が観察されたが、酸化物層の下地との界面近傍には平均厚さ43nmの気泡が実質的に存 在しない領域(層)が確認された。

また、上記表面酸化窒化アルミニウム製サセプタのウェハ搭載面の耐食性を以下の試験 50 I及びIEより評価した。

[0100]

〔試料のウェハ搭載面の耐食性試験Ⅰ〕

サセプタを10mm角に切り出し、ウェハ搭載面を上向きにして、プラズマリアクター 装置内の電極に載せた。そして、装置内に塩素ガスとアルゴンガスの1:1混合ガスを流 し、チャンバー内を20mTorrの圧力に保持して、100Wの電力で高周波プラズマ を発生させ、1時間エッチングした。処理前後の重量変化から求めたエッチング速度は0 .2µm/hr以下であった。

(24)

[0101]

さらに、上記耐食性試験後、試料のプラズマに曝された表面状態について、SEMによ 10 り観察したところ、酸化物層の部分的な脱落等は観察されず良好であった。

【 0 1 0 2 】

〔試料のウェハ搭載面の耐食性試験日(過酷条件)〕

サセプタを10mm角に切り出し、ウェハ搭載面を上向きにして、その半面をカプトン テープでマスキングして、プラズマリアクター装置内の電極に載せた。そして、装置内に 塩素ガスとアルゴンガスの20:1混合ガスを流し、チャンバー内を560mTorrの 圧力に保持して、114Wの電力で高周波プラズマを発生させ、5分間エッチングした。 処理後におい、ウェハ搭載面のカプトンテープを剥がし、マスキングされていた面とエッ チングされた面の高低差を測定したところ0.25µmであった。

【0103】

また、上記サセプタのエッチングされた面の任意の視野(40µm×30µm)につい て、電子顕微鏡(日立走査電子顕微鏡S-2150)を用いて表面状態を観察し、カプト ンテープでマスキングした部分、すなわち、プラズマ処理前の表面とプラズマに暴露され た表面の状態を比較した。観察は、加速電圧25kV、エミッション電流90µA、倍率 3000倍でおこなった。プラズマ処理前の表面状態の写真を図24、プラズマ処理後の 表面状態の写真を図25として示した。また、対象として、本実施例と同じ方法で製造し た窒化アルミニウム焼結体を加工したものではあるが、表面酸化は行っていない表面に酸 化層を有しない窒化アルミニウム製サセプタについて、同様のプラズマ処理試験の前後に おける各表面状態のSEM観察を行った。該表面に酸化層を有しない窒化アルミニウム製 サセプタのプラズマ処理前の表面状態の写真を図26、プラズマ処理後の表面状態の写真 を図27として示した。

[0104]

図24~27の写真の対比から明らかなように、まず、表面に酸化層を有しない窒化ア ルミニウム製サセプタ(対象試料)では、プラズマ処理により、内部の窒化アルミニウム の粒界が観察できるまでに、その表面が大きく侵食されていた。これに対して、本実施例 で得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタでは、プラズマ処理を受けても、酸化物 層表面に存在していた隆起したスジ状模様が消失し表面の平滑性が増してはいるものの、 窒化アルミニウムの下地は該酸化物層により良好に保護された状態が維持されていた。

[0105]

実施例 9

実施例8の窒化アルミニウム製サセプタを、実施例8と同じ装置を用い、保持時間を1 0時間に変更する以外は全て実施例8と同じ条件で酸化し、本発明の表面酸化窒化アルミ ニウム製サセプタを得た。

[0106]

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタ(試料)のウェハ搭載面について、X線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから、該試料の酸化物層は - アルミナであることが確認された。また、SEMによる表面観察結果を図28(写真)および図29(図28のイラスト)に、TEMによる酸化物層の断面観察結果を図30(写真) および図31(図30のイラスト)に示す。図28に示される様に、酸化物層の表面には 20



20

隆起による筋状の模様の他、特定クラックに該当しない軽微なクラック(枝分かれのない 幅の細いクラック)が観察された。また、任意の視野(半径30000nmの視野)50 箇所について同様の観察をしたところ、上記したような特定クラックに該当しない軽微な クラックが観察された領域はごく一部に止まり、何れの視野においても特定クラックは観 察されなかった。また、図30に示される様に、酸化物層には楕円状の気泡(若しくは空 隙)が観測されたが、酸化物層の下地との界面近傍には平均厚さ75nmの気泡が実質的 に存在しない領域(層)が確認された。なお、酸化物層の厚さは平均で3200nmであ った。

【0107】

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタのウェハ搭載面の耐食性を、実施例 8 と ¹⁰ 同じ方法で評価した。

まず、耐食性試験Iにおいて、プラズマ処理前後の重量変化から求めたエッチング速度 は0.2µm/hr以下であった。さらに、上記耐食性試験後、試料のプラズマに曝され た表面状態について、SEMにより観察したところ、酸化物層の部分的な脱落等は観察さ れず良好であった。

【0108】

また、耐食性試験IIにおいて、プラズマ処理後の、マスキングされていた面とエッチン グされた面の高低差は0.25µmであった。プラズマ処理前後の表面状態のSEM観察 の結果も、実施例8と同様に良好なものであった。

【0109】

実施例10

窒化アルミニウム粉末((株)トクヤマ製、Hグレード)100重量部、及び有機バインダーとしてアクリル酸メチルエステル4重量部より成る組成物を圧力500kg/cm ²で1軸プレス成形することにより、直径360mm、厚み16mmのグリーン体を得た

[0 1 1 0 **]**

このように得られたグリーン体を脱脂して有機バインダーを除去した後、窒化ホウ素製の密閉型焼成容器に入れ、窒素雰囲気中、1875の条件で焼成して、相対密度98% 以上、熱伝導率が90W/m・Kの緻密な窒化アルミニウム焼結体を得た。

得られた窒化アルミニウム焼結体を加工し、直径160mm、厚み5mm、ウェハ搭載 30 面の表面粗さがRa=0.05µm以下、その他の加工面の粗さがRa=0.8µmであ る実施例4と同様の形状の窒化アルミニウム製サセプタ(ウェハ保持器)を得た。

【 0 1 1 1 】

この窒化アルミニウム製サセプタを実施例8と同じ装置を用い、実施例8と同じ条件で 酸化し、本発明の表面酸化窒化アルミニウム製サセプタを得た。

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタ(試料)のウェハ搭載面について、X線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて 分析を行った。

【0112】

その結果、XRD測定の回折パターンから、該試料の酸化物層は - アルミナであるこ ⁴⁰ とが確認された。また該試料表面を実施例8と同装置、同試料作製方法、同観察条件で該 試料について表面SEM観察を行ったところ、任意の50視野において特定クラックは存 在せず、極めて緻密な酸化物層であることが判明した。さらに実施例4と同装置、同試料 作製方法、同観察条件で該試料酸化物層の断面TEM観察を行ったところ、窒化アルミニ ウム界面と酸化物層との界面近傍に約50nmの厚さの空隙非存在領域が存在することが 判明した。

【0113】

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタのウェハ搭載面の耐食性を、実施例 8 と 同じ方法で評価した。

まず、耐食性試験Iにおいて、プラズマ処理前後の重量変化から求めたエッチング速度 50

(25)

は0.2µm/hr以下であった。さらに、上記耐食性試験後、その試料表面について、 SEMにより表面観察したところ、酸化物層の部分的な脱落等は観察されなかった。 【0114】

(26)

また、耐食性試験IIにおいて、プラズマ処理後の、マスキングされていた面とエッチン グされた面の高低差は0.25µmであった。プラズマ処理前後の表面状態のSEM観察 の結果も、実施例8と同様に良好なものであった。

[0115**]**

実施例11

実施例 8 の窒化アルミニウム焼結体を加工し、直径 1 6 0 mm、厚み 5 mm、両平面の 表面粗さが R a = 0 . 0 5 µm以下、その他の加工面の粗さが R a = 0 . 8 µmである円 10 形の窒化アルミニウム製高周波導入用窓材を得た。

【0116】

この窒化アルミニウム製高周波導入用窓材を実施例8と同じ装置を用い、チャンバー内 面側表面を上に向けて炉内に固定して、実施例8と同じ条件で酸化し、本発明の表面酸化 窒化アルミニウム製高周波導入用窓材を得た。得られた表面酸化窒化アルミニウム製高周 波導入用窓(試料)のチャンバー内面側表面について、X線回折(XRD)、走査型電子 顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析を行った。

【 0 1 1 7 】

その結果、XRD測定の回折パターンから、該試料の酸化物層は - アルミナであることが確認された。また該試料表面を実施例8と同装置、同試料作製方法、同観察条件で該 20 試料表面SEM観察を行ったところ、特定クラックは存在せず、極めて緻密な酸化物層であることが判明した。さらに実施例4と同装置、同試料作製方法、同観察条件で該試料酸化物層の断面TEM観察を行ったところ、窒化アルミニウム界面と酸化物層との界面近傍に約55nmの厚さの空隙非存在領域が存在することが判明した。

【0118】

得られた表面酸化窒化アルミニウム製高周波導入用窓材の耐食性を実施例8に準じた方法で評価した。なお、試験I及びIIにおいて、上記窓材は、使用時にプラズマに曝される 面を上向きにしてプラズマリアクター装置内の電極に載せて試験を行った。

まず、耐食性試験Iにおいて、プラズマ処理前後の重量変化から求めたエッチング速度 は0.2µm/hr以下であった。さらに、上記耐食性試験後、その試料表面について、 SEMにより表面観察したところ、酸化物層の部分的な脱落等は観察されなかった。 【0119】

また、耐食性試験IIにおいて、プラズマ処理後の、マスキングされていた面とエッチン グされた面の高低差は0.25µmであった。プラズマ処理前後の表面状態のSEM観察 の結果も、実施例8と同様に良好なものであった。

【 0 1 2 0 】

比較例6(ディーガス処理なしの新酸化法の例)

実施例8で使用したものと同様の窒化アルミニウム製サセプタを、内径200mm、長 さ1100mmのムライトセラミックスを炉心管とする高温雰囲気炉内に、ウェハ搭載面 を上に向けて導入し、流速2(1/分)の窒素ガス(純度99.9995%、露点-8 0)、窒素流通下で1200 まで昇温した(昇温速度:3.3 /分)。サセプタ付 近温度が1200 に達したのを確認してから窒素ガスの流通を停止し、次いで酸素ガス (純度99.99%、露点-80)を流速1(1/分)で流通させ、そのまま1時間 保持してサセプタの表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し(降温速度3.3 /分)、本発明の表面酸化窒化アルミニウム製サセプタを得た。

【0121】

昇温開始と同時に炉から排出されるガスをガスクロマトグラフ(島津製作所製パーソナ ルガスクロマトグラフGC-8A)に導入し、ガス成分を経時的に分析した。昇温時には 窒素の他、微量の酸素及び水が検出された。別途作成した検量線を用いて、サセプタ温度 が1000 に達したときに排出されたガス中の酸素及び水の量を定量したところ酸素及

び水の濃度は、酸素が1.2mmol/m³(0.0027vol.%)であり、水が1 .0mmol/m³(0.0022vol.%)であった。両方の和が0.5mmol/ m³を超えることで酸化物層の下地との界面近傍に気泡(若しくは空隙)が発生すると考 えられた。

[0122]

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタ(試料)のウェハ搭載面について、実施 例4と同様にX線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから何れの試料の 酸化物層とも - アルミナであることが確認された。また、試料表面SEM観察を行った ところ、任意の50視野において特定クラックは存在せず、極めて緻密な酸化物層である ことが判明した。さらに酸化物層の断面TEM観察を行ったところ、酸化物層全体にわた り空隙若しくは気泡が存在することが確認された。

10

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタのウェハ搭載面の耐食性を、実施例8と 同じ方法で評価した。

まず、耐食性試験Iにおいて、プラズマ処理前後の重量変化から求めたエッチング速度 は0.2µm/hr以下であった。さらに、上記耐食性試験後、その試料表面について、 SEMにより表面観察したところ、僅かながら酸化物層の部分的な脱落が観察された。 [0124]

20 また、耐食性試験IIにおいて、プラズマ処理後の、マスキングされていた面とエッチン グされた面の高低差は0.25µmであった。プラズマ処理前後の表面状態のSEM観察 の結果も、実施例8と同様に良好なものであった。

[0125]

比較例7および8

実施例8で使用したものと同様の窒化アルミニウム製サセプタを、内径200mm、長 さ1100mmのムライトセラミックスを炉心管とする高温雰囲気炉内に導入し、流速2 (1/分)のdry-air流通下で1200 まで昇温した(昇温速度:3.3 /分)。サセプタ付近温度が1200 に達したのを確認してからそのまま1時間保持してサ セプタの表面を酸化した。酸化終了後室温まで冷却し(降温速度3.3 /分)、表面酸 化窒化アルミニウム製サセプタを得た(比較例7)。また、保持時間を10時間に変更す る以外は全て比較例7と同じ条件で酸化し、表面酸化窒化アルミニウム製サセプタを得た (比較例8)。

[0126]

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタ(試料)のウェハ搭載面について、実施 例8と同様にX線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて分析を行った。その結果、XRD測定の回折パターンから何れの試料の 酸化物層とも - アルミナであることが確認された。また、酸化物層の厚さは比較例7の 試料が平均で1400nmであり、比較例8の試料が平均で16000nmであった。 [0127]

40 また、比較例7の試料のSEMによる表面観察結果を図32(写真)および図33(図 32のイラスト)に、比較例8の試料のSEMによる表面観察結果を図34(写真)およ び図35(図34のイラスト)に示す。また、図32および図34に示される様に、両試 料の酸化物層表面には隆起による筋状の模様の他に特定クラックが観察された。因みにS EM写真に基づいて各試料の酸化物層表面に存在するクラックについて最も大きなw/1 を示すクラックユニットにおけるw、1及びw/1は、比較例7の試料ではw=120n m、1=2800nm、w/1=0.04であり、比較例8の試料ではw=150nm、 1 = 3 5 0 0 n m、w / 1 = 0 . 0 4 であった。また、任意の視野(半径 3 0 0 0 n m の視野)50箇所について同様の観察をしたところ、比較例7については合計33個、比 較例8については合計36個の特定クラックが観察された。 [0128] 50

(27)

また、比較例7の試料のTEMによる断面観察結果を図36(写真)および図37(図3 6のイラスト)に、比較例8の試料のTEMによる断面観察結果を図38(写真)および 図39(図38のイラスト)に示す。図36及び38に示される様に、何れの酸化物層に おいても楕円状の気泡(若しくは空隙)が観察された。そして、実施例8とは異なり、何 れの試料においても気泡は酸化物層の下地との界面近傍にも確認された。

【0129】

得られた表面酸化窒化アルミニウム製サセプタのウェハ搭載面の耐食性を実施例 8 と同 じ方法で評価した。

まず、耐食性試験Iにおいて、プラズマ処理前後の重量変化から求めたエッチング速度 は、比較例7が0.6µm/hr、比較例8が1µm/hrであった。さらに、上記耐食 ¹⁰ 性試験後、その試料表面について、SEMにより表面観察したところ、比較例7および比 較例8共に酸化物層に部分的な脱落が観察された。

[0130]

また、耐食性試験IIにおいて、プラズマ処理後の、マスキングされていた面とエッチン グされた面の高低差は、比較例7が0.36µmであり、比較例8が0.40µmであっ た。

【産業上の利用可能性】

【0131】

本発明の方法によれば、窒化アルミニウムや窒化珪素等の窒化物系セラミックス、炭化 珪素等の炭化物系セラミックスなどの非酸化物セラミックス焼結体の表面に非常に高品位 な酸化膜を形成することができ、従来法で酸化した場合と比べて酸化膜の形成によりもた らせる様々な効果、例えば耐水性や耐薬品性の向上、耐プラズマ性の向上、機械的強度の 向上といった効果をより高いものとすることができ、更にその信頼性や耐久性も高くする ことができる。特に、本発明の方法で製造される「表面に酸化物層を有する非酸化物セラ ミックス焼結体」は、その酸化層が、従来法で形成された酸化膜で観測される分岐の多い 特徴的なクラックを実質的に含まないばかりでなく非酸化物セラミックス基材との界面近 傍に空隙が実質的に存在しないという構造的特徴を有するため、非酸化物セラミックス基 材と酸化物層との密着強度が非常に高い。このため、上記したような様々な効果の信頼性 や耐久性も高くすることができる。

【0132】

本発明の冷却装置は、その冷却ジャケットが熱伝導性の高い非酸化物セラミックスから 成っているにもかかわらず、その接液面が高品質の酸化物層で覆われているため、冷却媒 として水や水性溶液を用いても非酸化物セラミックスが劣化することが無い。更に、酸化 物層は下地の非酸化物セラミックスと強固に密着している。そのため、冷却媒に含まれる イオン化物の量を厳重に特に管理しなくても長期間安定に使用することができる。 【0133】

本発明の耐プラズマ性部材は、窒化アルミニウム等の非酸化物セラミックスで形成され ているにも関わらず、表面には、幅が広く枝分かれの多いクラックは形成されておらず緻 密性が高いため、ハロゲン系腐食性ガスなどのプラズマに曝されても劣化が生じ難い。す なわち、こうしたプラズマに曝された場合において、表面の腐食による劣化が大きく低減 できる。したがって、部材が半導体や液晶の製造プロセスにおいて使用されるチャンバー 構成部材であった場合においては、表面の腐蝕によるパーティクルの発生が抑制でき、ウ ェハの汚染防止に大きな効果が発揮される。

【0134】

また、さらに、腐食が進んだ時に引き起こされる、部材表面の形状変化も抑制でき、例 えば、上記チャンバー構成部材のウェハ保持器として使用した際には、ウェハ保持の確実 性が長期間にわたって維持できる。

その他、表面に緻密な酸化物層が形成されているため、内部への熱伝導の均一性も改善 され、放熱性状や温度分布の均一化にも有効である。更に、酸化物層は下地の非酸化物セ ラミックスと強固に密着しているため、たとえば使用環境の温度変化が大きいといった過 30

20

酷な条件下で使用された場合でもその効果を長期間保つことができる。







【図4】





【図8】 酸化物層表面 ・ ・ ・ ・ ・ 陸起したスジ状模様

、 隆起した部分















【図3】

【図5】

【図9】

【図13】

【図15】

【図17】

【図20】

【図22】

【図24】

【図26】

【図28】

【図30】

【図32】

【図34】

【図36】

【図38】

フロントページの続き

- (31)優先権主張番号 特願2004-199974(P2004-199974)
- (32)優先日 平成16年7月7日(2004.7.7)
- (33)優先権主張国 日本国(JP)
- (72)発明者 米田 武彦山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内
- (72)発明者 有行 正男山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内
- (72)発明者 砂押 毅志茨城県ひたちなか市中根3327
- (72)発明者 佐藤 秀樹山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内
 - 審査官 小川 武

(56)参考文献 特開平09-232409(JP,A)
特開2002-274949(JP,A)
特開2000-150752(JP,A)
特開2001-181049(JP,A)
国際公開第2005/075382(WO,A1)
特許第4475973(JP,B2)
特許第4277134(JP,B2)
特許第4312069(JP,B2)
福山博之,田上哲治,永田和宏,窒化アルミニウムの高温酸化機構の解明と新しい表面改質法の
開発,資源・素材学会秋季大会,2002年 9月23日,2002(熊本),p.351-3 52

(58)調査した分野(Int.CI., DB名) C04B 35/00-35/64 C04B 41/00-41/91

H01L 35/00-35/34